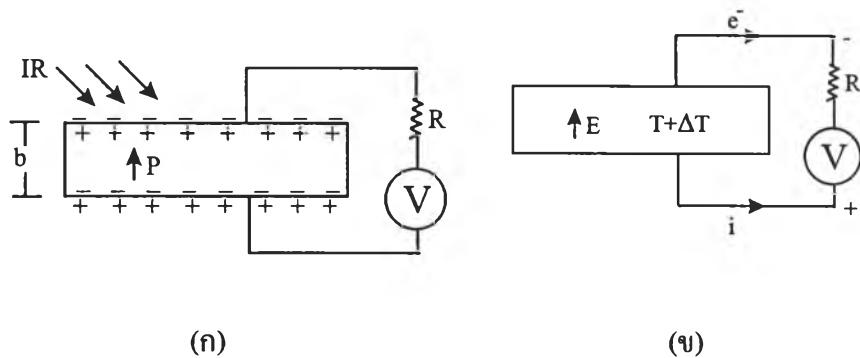


## บทที่ 5

### ความต่างศักย์จากฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF

หลังจากได้ฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF ที่มีสัมประสิทธิ์ไพโรอิเล็กทริกปานกลางหรือค่อนข้างสูง ขั้นตอนต่อไปจะนำฟิล์มนี้ไปศึกษาความต่างศักย์จากฟิล์มเมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มต่าง ๆ ตกกระทบฟิล์ม เพื่อนำข้อมูลนี้ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาอุปกรณ์ตัวรับรู้ไพโรอิเล็กทริกต่อไป

#### 5.1 ความต่างศักย์จากฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF (เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทันทีทันใด)



รูปที่ 5.1 (ก) และ (ข) แสดงการใช้โวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานภายใน  $R$  วัดความต่างศักย์เมื่อมีรังสีอินฟราเรดตกกระทบฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF

จากรูปที่ 5.1 ฟิล์มไพโรอิเล็กทริกที่มีพื้นที่อิเล็กโทรด  $A$  หนา  $b$  ต่อกับโวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานภายใน  $R$  ถ้าทิ้งไว้นาน ๆ โวลต์มิเตอร์จะอ่านศูนย์ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของประจุอิสระไปรวมกับประจุโพลาริเซชัน ทำให้ฟิล์มอยู่ในสภาพเป็นกลาง เมื่อมีรังสีอินฟราเรดมาตกกระทบฟิล์มทำให้ฟิล์มมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น  $T + \Delta T$  อย่างรวดเร็ว โพลาริเซชันของฟิล์มเปลี่ยนเป็น  $P - \Delta P$  ในช่วงเวลาที่สั้นมาก ๆ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าคิดว่าความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์มีค่ามาก ประจุอิสระจะยังไม่เกิดการถ่ายเทระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสอง ดังนั้นอาจจะพิจารณาให้อยู่ในภาวะวงจรเปิดได้ ( $\Delta D = 0$ ) จะเกิดความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าขึ้นที่อิเล็กโทรดทั้งสองของฟิล์ม จากสมการ (2.16) จะหาความต่างศักย์ของวงจรเปิด (ในตอนแรก) ได้เป็น

$$V = \frac{pb\Delta T}{K\varepsilon_0} \quad (5.1)$$

เมื่อ  $K$  คือค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของฟิล์ม

จากนั้นประจุจะเริ่มเคลื่อนย้ายผ่านความต้านทานภายใน  $R$  ทำให้ความต่างศักย์ที่อิเล็กโทรดจะค่อย ๆ ลดลง ต่อไปจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  $V$  กับประจุอิสระ  $\pm Q$  ที่อิเล็กโทรดทั้งสอง

จากสมการ (2.13) และ (2.14) จะได้

$$E = \frac{Q}{A\varepsilon_0} - \frac{P_r}{\varepsilon_0} - \chi_r E - \frac{p\Delta T}{\varepsilon_0} \quad (5.2)$$

สมการ (5.2) ถ้าจัดเทอมใหม่ จะได้

$$V = \frac{Q}{C} - \frac{Q_0}{C} \quad (5.3)$$

$$\text{เมื่อ} \quad Q_0 = (P_r + p\Delta T)A \quad (5.4)$$

$$C = \frac{K\varepsilon_0 A}{b} \quad (5.5)$$

โดย  $Q_0$  คือประจุที่ผิวของอิเล็กโทรดขณะที่สนามไฟฟ้าและความต่างศักย์ลดลงเป็นศูนย์

จากรูปที่ 5.1 (ข) ขณะที่มีการเสถียรจากฟิล์ม ถ้า  $\Delta T$  คงที่ ทำให้เทอม  $\frac{Q_0}{C}$  คงที่ด้วย จะเห็นว่าความต่างศักย์  $V$  ในกรณีที่ฟิล์มเป็นสารไพโรอิเล็กทริก และไดอิเล็กทริกนั้นต่างกัน เพราะในกรณีของสารไดอิเล็กทริก

$$V = \frac{Q}{C} \quad (5.6)$$

เมื่อ  $C$  คือความจุไฟฟ้า ที่นิยามดังสมการ (5.5)

ในรูปที่ 5.1 (ข) ขณะที่มีการเคลื่อนย้ายประจุ จะทำให้ความต่างศักย์  $V$  ค่อย ๆ ลดลง ซึ่งจากสมการ (5.3) จะได้

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} \quad (5.7)$$

โดย  $i$  คือเวลา และจากนิยามของกระแสไฟฟ้า

$$i = -\frac{dQ}{dt}$$

นั่นคือ กระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นผลมาจากอัตราการลดลงของประจุบนฟิล์ม

ดังนั้น จะได้

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{i}{C} = -\frac{V}{RC} \quad (5.8)$$

นั่นคือ

$$V = V_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \quad (5.9)$$

เมื่อ  $RC$  คือเวลาผ่อนคลายทางไฟฟ้า

จะเห็นได้ว่า ความต่างศักย์ที่ลดลงของอิเล็กโทรดในกรณีของฟิล์มไพโรอิเล็กทริกหรือไดอิเล็กทริกจะเหมือนกัน และความจุของฟิล์มก็คำนวณได้จากสมการ (5.5) เหมือนกันทั้งสองกรณี ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับประจุจะต่างกันดังสมการ (5.3) และสมการ (5.6)

จากที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้วว่า ประจุจะเคลื่อนย้ายออกจากฟิล์มอย่างรวดเร็ว ทำให้เราอ่านความต่างศักย์จากโวลต์มิเตอร์ไม่ทัน ดังนั้นในการอ่านความต่างศักย์จากฟิล์มเมื่อมีรังสี-

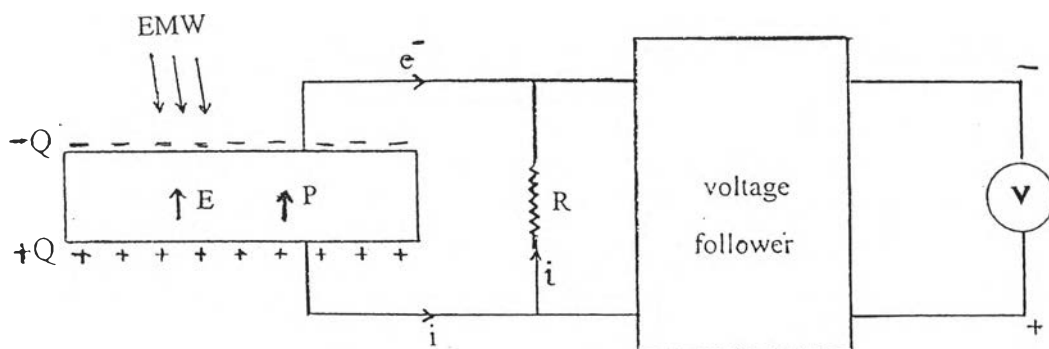
อินฟราเรดตกกระทบทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องไม่มีการดึงประจุออกจากอิเล็กโทรดของฟิล์มเลย ซึ่งทำได้โดยใช้ออปแอมป์ (operational amplifier) นำมาต่อวงจรตามแรงดัน (voltage follower “VF”) ซึ่งวงจรมีความต้านทานเข้า (input impedance) สูงมาก เพื่อต้องการให้ความต้านทานออก (output impedance) มีค่าต่ำ

## 5.2 ความต่างศักย์จากฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF (เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)

ในหัวข้อที่แล้ว เป็นการหาความต่างศักย์จากฟิล์มเมื่อวัดโดยโวลต์มิเตอร์เชิงตัวเลข เมื่ออุณหภูมิของฟิล์มเพิ่มขึ้นทันทีทันใด ซึ่งเป็นกรณีที่ง่ายต่อการพิจารณา ตอนนี้จะพิจารณาเมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetics wave) มาตกกระทบฟิล์ม ทำให้ฟิล์มมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และดูความต่างศักย์จากฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

จากสมการ (5.3) ถึงสมการ (5.5) ถ้าฟิล์มมีอุณหภูมิ  $T = T_0 + \Delta T$  โดย  $T_0$  คืออุณหภูมิห้อง และอิเล็กโทรดทั้งสองของฟิล์มมีประจุ  $\pm Q$  จะได้ความต่างศักย์ของฟิล์ม

$$V = \frac{Q}{C} - \frac{(P_r + p\Delta T)A}{C} \quad (5.10)$$



รูปที่ 5.2 แสดงการวัดความต่างศักย์จากฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF ที่มีความต้านทาน  $R$  ต่อขนาน เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบ

จากรูปที่ 5.2 เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบฟิล์ม ฟิล์มจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีความต่างศักย์เกิดขึ้นที่อิเล็กโทรด ทำให้กระแสไหลผ่านความต้านทาน  $R$  ซึ่งอ่านได้โดยโวลต์มิเตอร์โดยใช้วงจรตามแรงดันเข้าช่วย

$$\text{เนื่องจาก} \quad \frac{d(\Delta T)}{dt} = \frac{dT}{dt}$$

และจากสมการ (5.10) จะได้

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} - \frac{pA}{C} \frac{dT}{dt}$$

$$\text{เนื่องจาก} \quad i = -\frac{dQ}{dt} = \frac{V}{R}$$

$$\text{จะได้} \quad \frac{dV}{dt} = -\frac{V}{RC} - \frac{pA}{C} \frac{dT}{dt} \quad (5.11)$$

$$\text{ถ้าความต่างศักย์เพิ่มขึ้นสูงสุด นั่นคือ} \quad \frac{dV}{dt} = 0 \quad \text{จะได้}$$

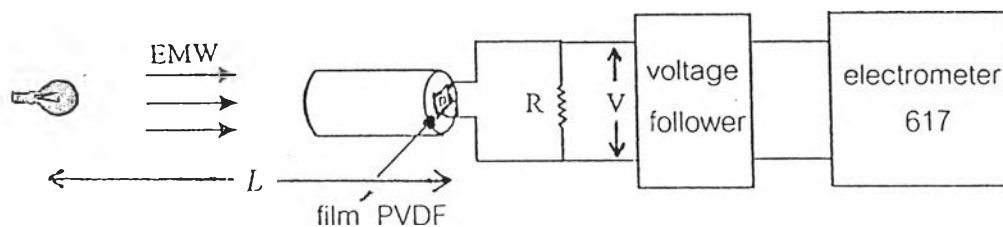
$$V_{\max} = -ARp \frac{dT}{dt} \quad (5.12)$$

สมการ (5.12) จะเห็นได้ว่า  $V_{\max}$  มีค่าเป็นบวก (เนื่องจากสัมประสิทธิ์ไพโรอิเล็กทริกที่วัดได้มีค่าเป็นลบ) ถ้าอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเป็นบวก (อุณหภูมิของฟิล์มกำลังเพิ่มขึ้น) จากสมการข้างบนความต่างศักย์สูงสุดที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของอิเล็กโทรด ความต้านทานที่ต่อขนาน และอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ

ในการวิจัยนี้จึงได้ทำการทดลองเพื่อจะทดลองฟิล์มที่จะนำไปใช้เป็น IR sensor โดยจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์สูงสุดกับพื้นที่ของอิเล็กโทรด และความต้านทานที่ต่อขนานกับฟิล์ม เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาตกกระทบ โดยจะใช้ฟิล์ม PVDF พาณิชย (commercial) ความหนาประมาณ 80 ไมโครเมตร นำมายึดแล้วจัดขั้วที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ความต่างศักย์ 2500 โวลต์ ก็จะได้ฟิล์มไพโรอิเล็กทริกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ไพโร-

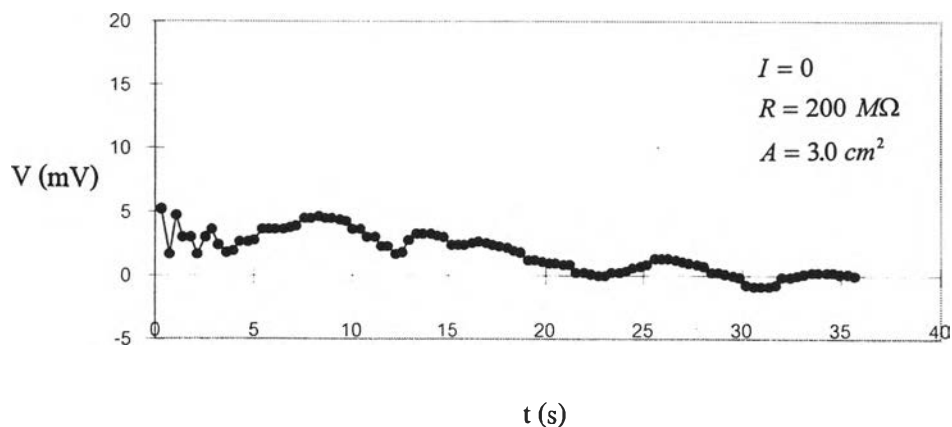
อิเล็กทริก ประมาณ  $1.2 \times 10^{-5}$  คูლობ์ต่อตารางเมตรเคลวิน จากนั้นตัดฟิล์มเป็น 2 ส่วน พื้นที่ 3.0 และ 9.0 ตารางเซนติเมตร มีขั้นตอนการทดลองดังนี้

พิจารณารูปที่ 5.3 ซึ่งเป็นการทดลองวัดความต่างศักย์จากฟิล์ม เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มต่าง ๆ ตกกระทบฟิล์ม โดยนำฟิล์มไว้ที่ด้านหลังทรงกระบอกที่รัศมี 4 เซนติเมตร ต่อขั้วไฟฟ้าจากอิเล็กโทรคทั้งสองของฟิล์มเข้ากับขาเข้าของวงจรตามแรงดัน และมีหลอดไฟ ชนิดไส้ กำลัง 100 วัตต์ วางห่างจากฟิล์มเป็นระยะ  $L$  ดังรูป เพื่อลดสัญญาณรบกวนจากฟิล์ม จึงใช้ความต้านทาน 200 เมกะโอห์ม หรือ 1000 เมกะโอห์ม ต่อขนานกับฟิล์ม สัญญาณ ความต่างศักย์จากฟิล์มที่ผ่านวงจรตามแรงดันซึ่งวัดโดยใช้อิเล็กโทรมิเตอร์ (KEITHLEY 617 programmable electrometer) จะโปรแกรมให้เครื่องนี้บันทึกความต่างศักย์ทุก ๆ 0.36 วินาที

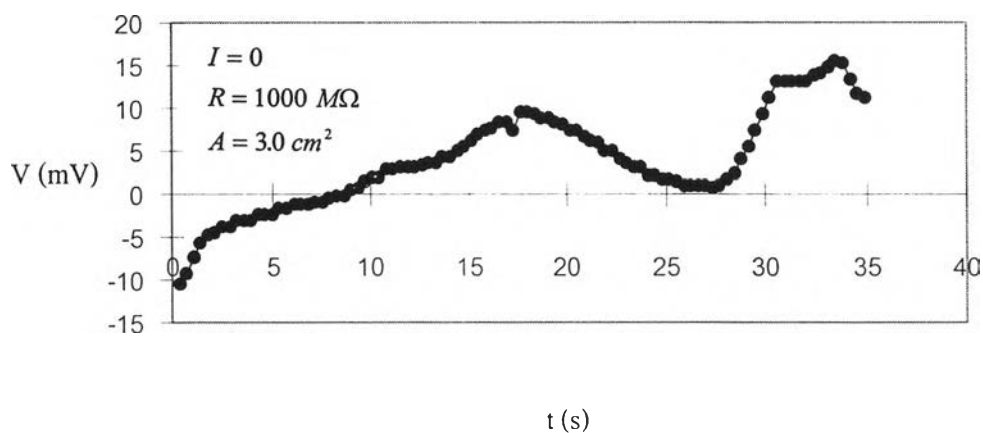


รูปที่ 5.3 แสดงการทดลองวัดความต่างศักย์ระหว่างอิเล็กโทรคทั้งสองของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มต่าง ๆ ตกกระทบฟิล์ม

ตอนแรก จะวัดความต่างศักย์ขณะที่ไม่เปิดหลอดไฟ นั่นคือไม่มีรังสีใด ๆ นอกจาก รังสีพื้น (background) ตกกระทบฟิล์ม สัญญาณจากฟิล์มก็คือสัญญาณรบกวน (noise) นั่นเอง ซึ่งตามทฤษฎีแล้วเมื่อความต้านทาน  $R$  มากขึ้น สัญญาณรบกวนจะมากขึ้นด้วย ได้ผลการทดลอง ดังรูปที่ 5.4 และ 5.5



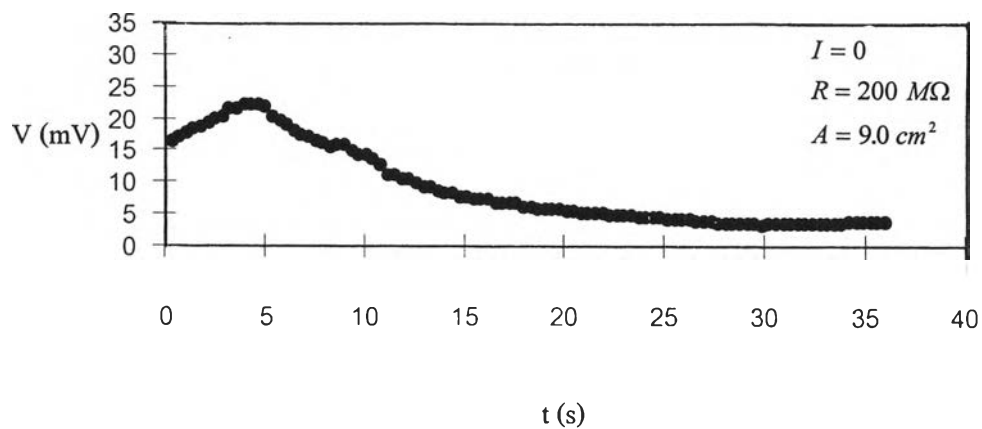
(ก)



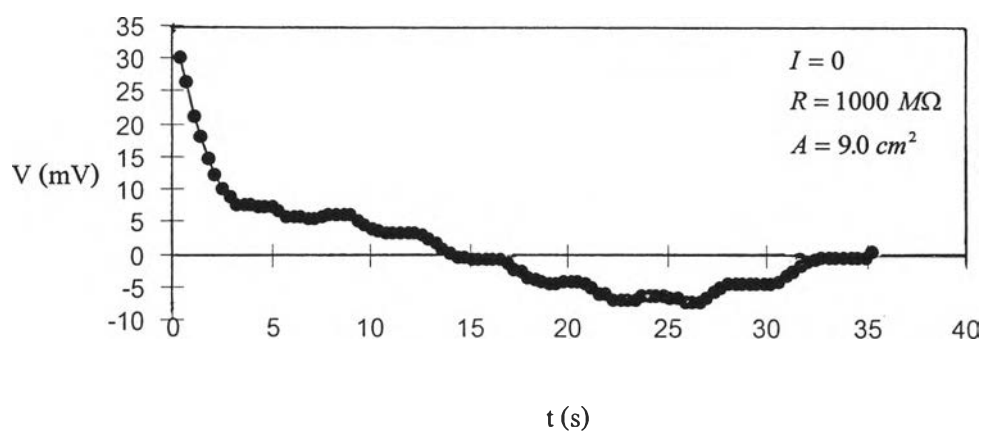
(ข)

รูปที่ 5.4 (ก) และ (ข) แสดงความต่างศักย์จากฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นเล็กพื้นที่ อิเล็กโตรด 3.0 ตารางเซนติเมตร เมื่อไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาตกกระทบ มีความต้านทาน 200 เมกะโอห์ม และ 1000 เมกะโอห์มต่อขนาน ตามลำดับ

จากรูปที่ 5.4 จะเห็นได้ว่าสัญญาณรบกวนของฟิล์มแผ่นเล็ก ไม่น่าจะมากกว่า 7 มิลลิโวลต์และ 20 มิลลิโวลต์ เมื่อมีความต้านทาน 200 เมกะโอห์ม และ 1000 เมกะโอห์ม ต่อขนานกับ ฟิล์ม ตามลำดับ



(ก)



(ข)

รูปที่ 5.5 (ก) และ (ข) แสดงความต่างศักย์จากฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นใหญ่ พื้นที่อิเล็กโทรด  $9.0$  ตารางเซนติเมตร เมื่อไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาตกกระทบ มีความต้านทาน  $200$  เมกะโอห์ม และ  $1000$  เมกะโอห์มต่อขนาน ตามลำดับ

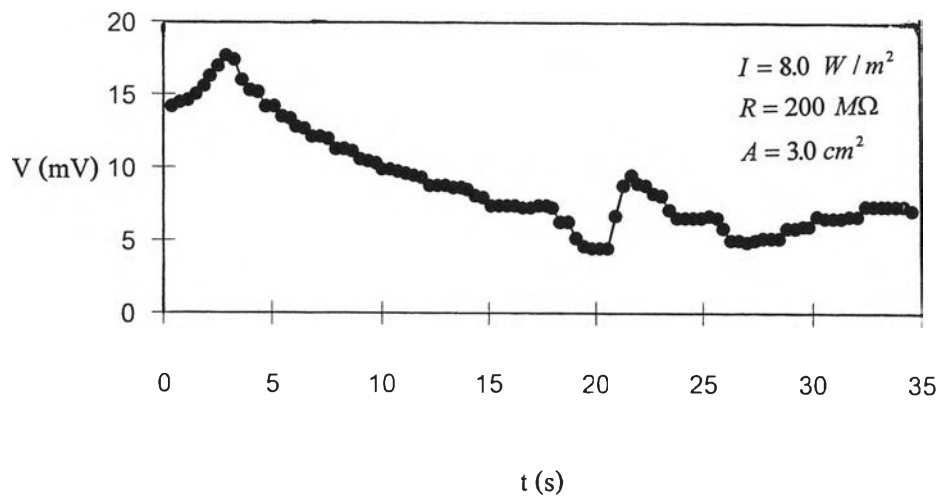
จากรูปที่ 5.5 จะเห็นได้ว่าสัญญาณรบกวนของฟิล์มแผ่นใหญ่ ไม่น่าจะมากกว่า  $25$  มิลลิโวลต์ และ  $35$  มิลลิโวลต์ เมื่อมีความต้านทาน  $200$  เมกะโอห์ม และ  $1000$  เมกะโอห์ม ต่อขนานกับฟิล์ม ตามลำดับ



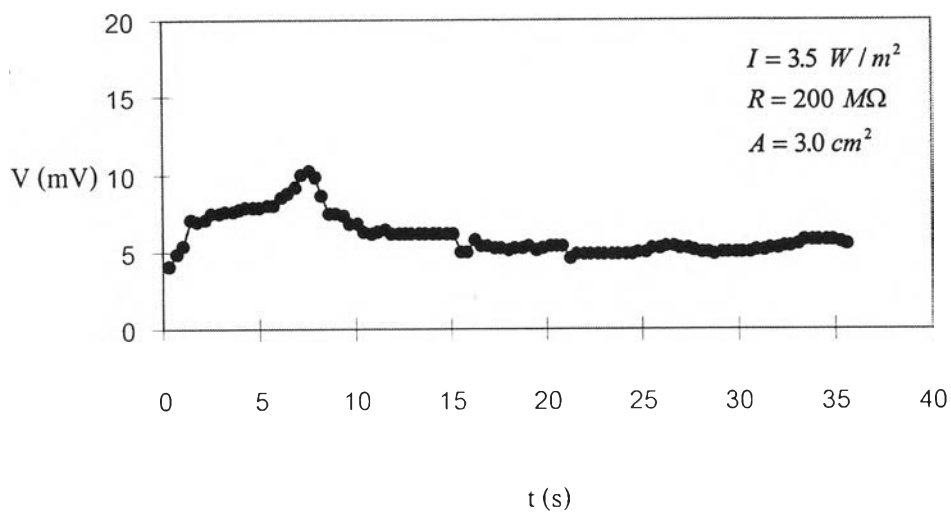
ในงานวิจัยนี้ต้องการจะนำฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF ไปประดิษฐ์เครื่องมือ เช่น เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก เครื่องเตือนไฟไหม้ ในการทดลองจึงต้องการศึกษาว่าถ้ามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มต่าง ๆ ตกกระทบฟิล์มแล้วฟิล์มจะให้ความต่างศักย์สูงสุดเท่าใด เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับสถานการณ์จริง ดังนั้นขั้นตอนต่อไป จะฉายแสงความเข้มต่าง ๆ ตกกระทบฟิล์ม โดยความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( $I$ ) จากหลอดไฟที่ตกกระทบฟิล์มในแนวตั้งฉากจะเป็นไปตามกฎกำลังสองผกผัน (inverse square law) คือความเข้มจะแปรผกผันกับกำลังสองของระยะ  $L$  ในที่นี้อาจถือได้ว่าหลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดจุด (point source) เนื่องจากไส้หลอด (filament) มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่า  $L$  ที่ใช้มาก ดังนั้นจะได้

$$I = \frac{100}{4\pi L^2} \quad W / m^2 \quad (5.13)$$

โดยทั่วไปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปล่งออกมาจากหลอดไฟจะเป็นแสงที่ตามองเห็นได้ (visible light) ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นจะเป็นรังสีอินฟราเรด แต่ทั้งสองชนิดก็มีส่วนที่ทำให้ฟิล์มมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลการทดลองแสดงได้ดังรูปที่ 5.6-5.9

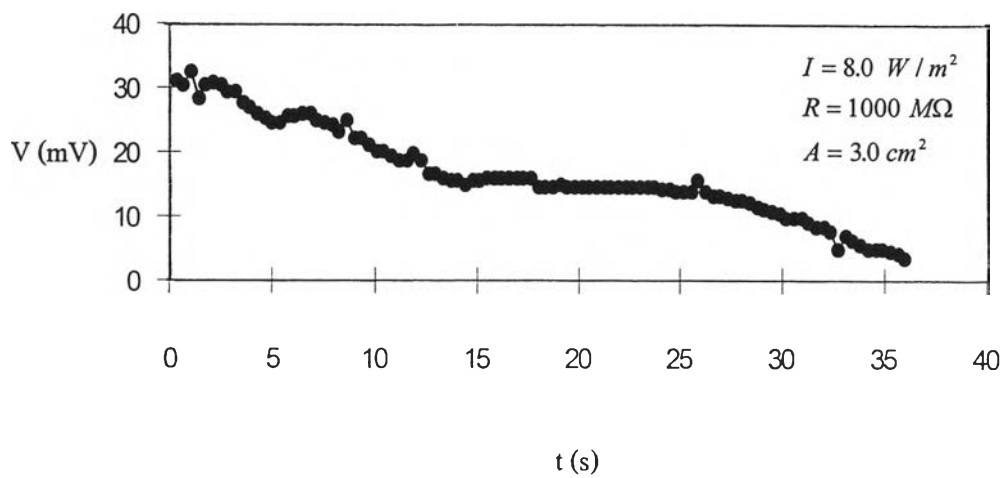


(ก)

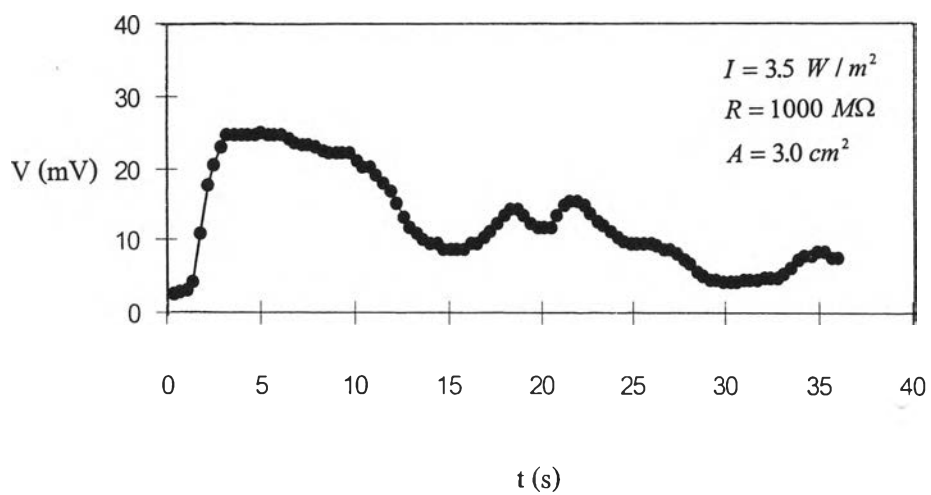


(ข)

รูปที่ 5.6 (ก) และ (ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นเล็กพื้นที่อิเล็กโทรด 3.0 ตารางเซนติเมตร ไปด้วยเวลา เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหลอดไฟความเข้ม 8.0 และ 3.5 วัตต์ต่อตารางเมตร ตกกระทบฟิล์ม โดยมีความต้านทาน 200 เมกะโอห์ม ต่อขนานกับฟิล์ม ตามลำดับ

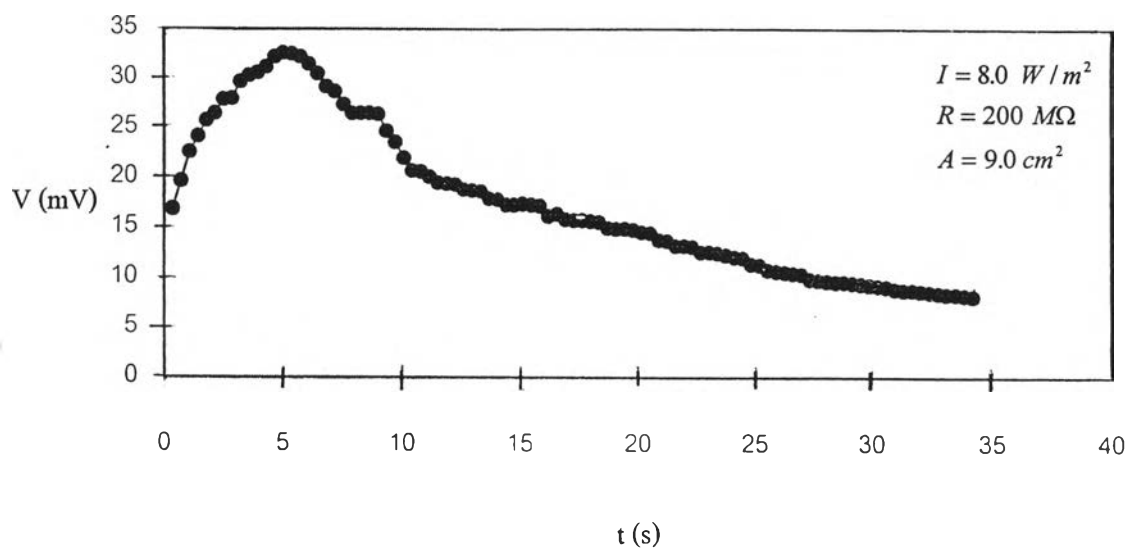


(ก)

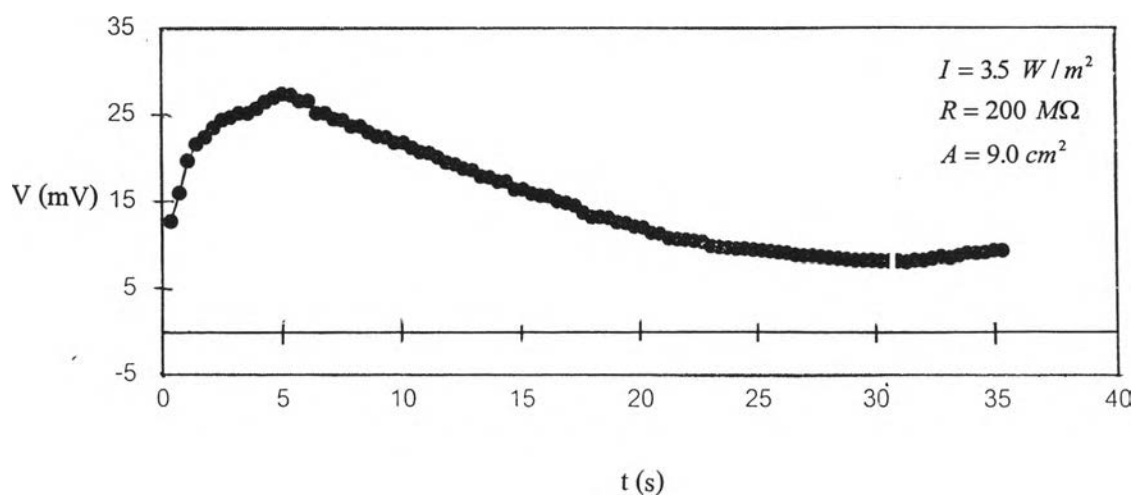


(ข)

รูปที่ 5.7 (ก) และ (ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นเล็กพื้นที่อิเล็กโทรด 3.0 ตารางเซนติเมตร ไปด้วยเวลา เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหลอดไฟความเข้ม 8.0 และ 3.5 วัตต์ต่อตารางเมตร ตกกระทบฟิล์ม โดยฟิล์มมีความต้านทาน 1000 เมกะโอห์มต่อขนาน ตามลำดับ

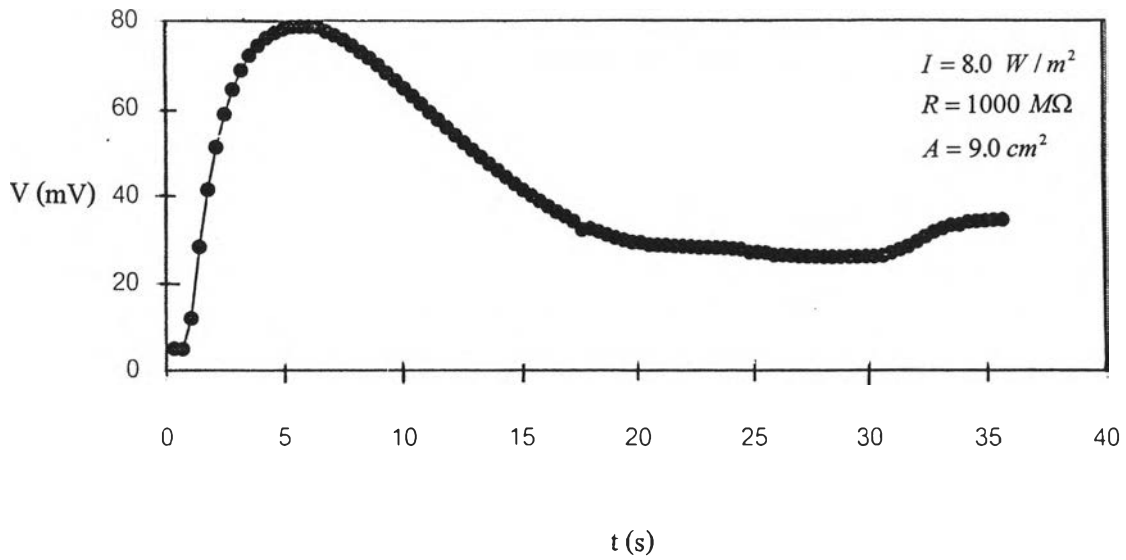


(ก)

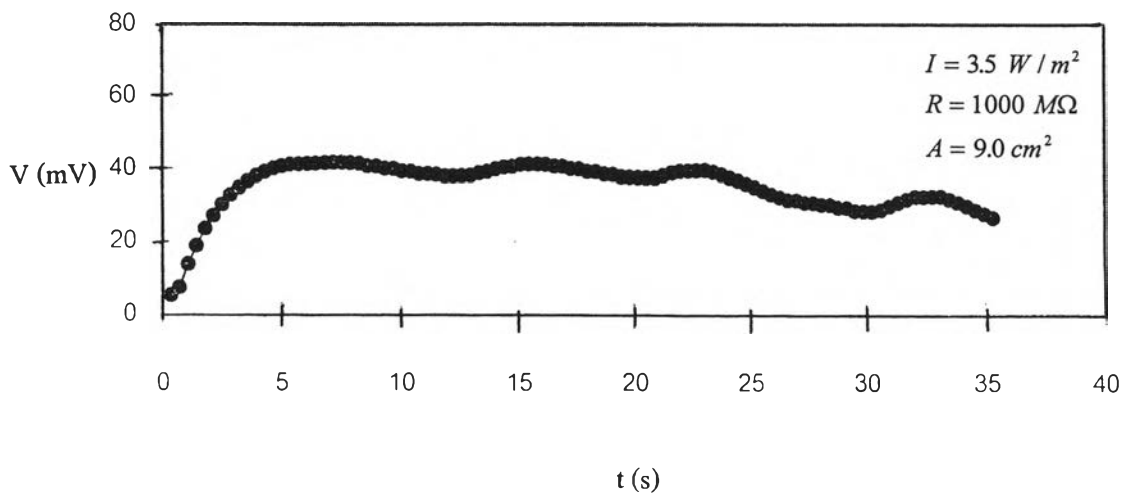


(ข)

รูปที่ 5.8 (ก) และ (ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นใหญ่พื้นที่อิเล็กโทรด 9.0 ตารางเซนติเมตร ไปด้วยเวลา เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหลอดไฟความเข้ม 8.0 และ 3.5 วัตต์ต่อตารางเมตร ตกกระทบฟิล์ม โดยมีความต้านทาน 200 เมกะโอห์มต่อขนานกับฟิล์ม ตามลำดับ



(ก)



(ข)

รูปที่ 5.9 (ก) และ (ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นใหญ่พื้นที่อิเล็กโทรด 9.0 ตารางเซนติเมตร ไปด้วยเวลา เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหลอดไฟความเข้ม 8.0 และ 3.5 วัตต์ต่อตารางเมตร ตกกระทบฟิล์ม โดยมีความต้านทาน 1000 เมกะโอห์มต่อขนานกับฟิล์ม ตามลำดับ

จากผลการทดลอง สรุปได้ดังนี้

1. สัญญาณรบกวนจากฟิล์มจะมากขึ้น ถ้าความต้านทานที่ต่อขนานกับฟิล์มสูงขึ้น
2. สัญญาณรบกวนจากฟิล์มจะมากขึ้น ถ้าฟิล์มมีพื้นที่อิเล็กโทรดมาก
3. ความต่างศักย์สูงสุดของฟิล์มจะมากขึ้น ถ้าความต้านทานที่ต่อขนานมากขึ้น (เมื่อฟิล์มได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มเท่ากัน)
4. ถ้าความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้น (อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงขึ้น) จะทำให้ความต่างศักย์สูงสุดของฟิล์มเพิ่มขึ้นด้วย
5. ฟิล์มแผ่นใหญ่น่าจะนำไปใช้งานได้ดีกว่าฟิล์มแผ่นเล็ก

ข้อ 3 และ 4 เป็นไปตามสมการ (5.12)

ดังนั้น จากผลการทดลองในรูปที่ 5.4 - 5.9 สามารถนำมาสรุปได้ดังตารางที่ 5.1 และ 5.2

ตารางที่ 5.1 แสดงความต่างศักย์สูงสุด ( $V_{\max}$ ) หน่วยเป็นมิลลิโวลต์ ของฟิล์มแผ่นเล็ก พื้นที่อิเล็กโทรด 3.0 ตารางเซนติเมตร

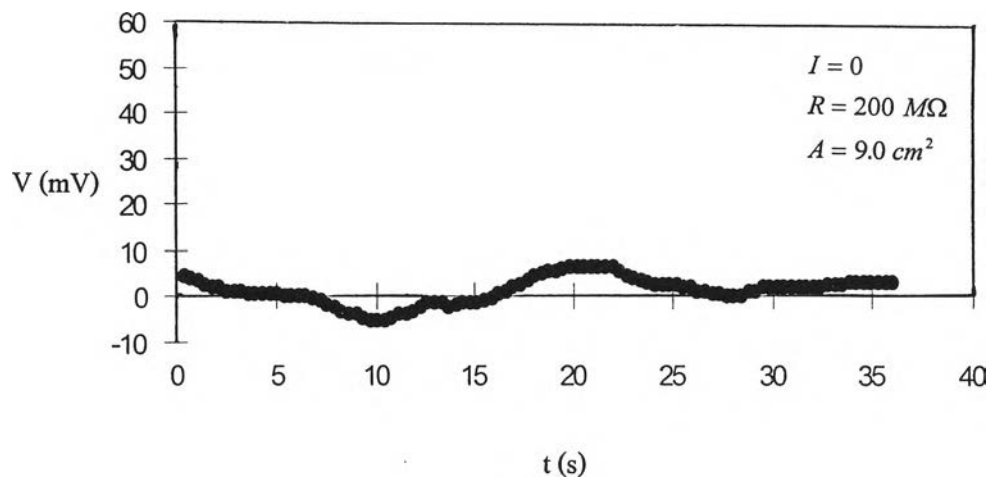
$I (W / m^2)$	$R = 200 M\Omega$	$R = 1000 M\Omega$
0	7.0	20.0
3.5	10.7	25.2
8.0	17.9	32.6

ตารางที่ 5.2 แสดงความต่างศักย์สูงสุด ( $V_{\max}$ ) หน่วยเป็นมิลลิโวลต์ ของฟิล์มแผ่นใหญ่ พื้นที่อิเล็กโทรด 9.0 ตารางเซนติเมตร

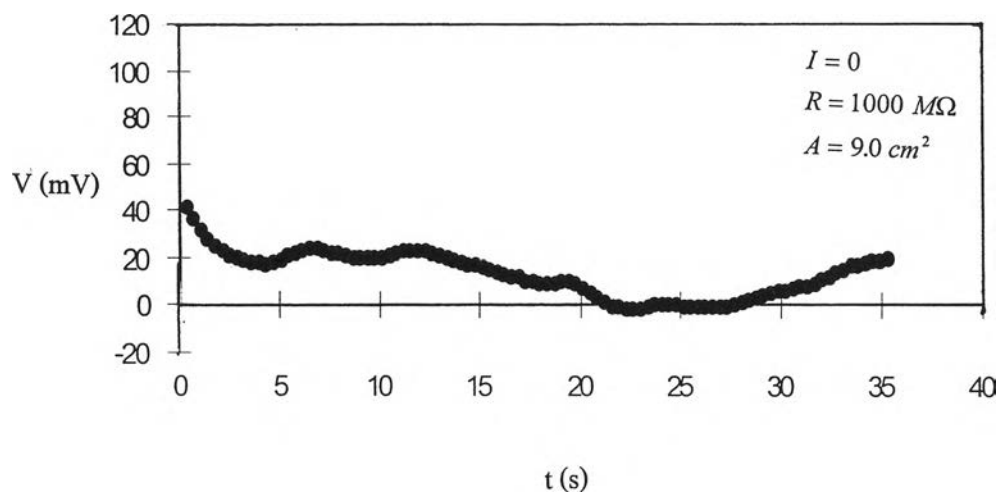
$I (W / m^2)$	$R = 200 M\Omega$	$R = 1000 M\Omega$
0	25.0	35.0
3.5	28.5	44.2
8.0	33.1	79.4

จากการทำการทดลองดังรูปที่ 5.3 ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง สำหรับค่าความต้านทานที่ค่อนข้างเดียวกัน และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มเดียวกัน พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ไปกับเวลา มีค่าไม่เท่ากันทุกครั้ง แต่ไม่แตกต่างกันมากนัก ขึ้นอยู่กับสัญญาณรบกวน ดังนั้นควรทดลองในช่วงเวลากลางคืนสัก ๆ หรือขณะที่ภายในห้องไม่มีการทำงาน

นอกจากนี้ในการวิจัยยังได้พัฒนาให้ฟิล์มไพโรอิเล็กทริกสามารถดูดคลื่นรังสีอินฟราเรดได้มากขึ้น โดยทำให้อิเล็กโทรดด้านที่รับรังสีอินฟราเรดเป็นสีดำ (black paint) ในการทดลองใช้ฟิล์มแผ่นใหญ่ทำการทดลองเหมือนที่ทำมาแล้วข้างต้น เพื่อเปรียบเทียบกัน ได้ผลการทดลองดังรูปที่ 5.10-5.12 และสรุปผลได้ดังตารางที่ 5.3



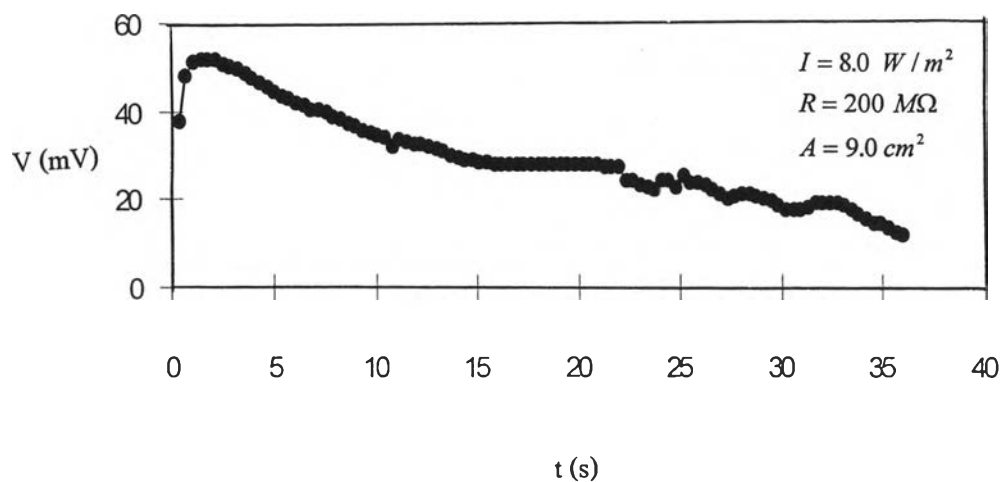
(ก)



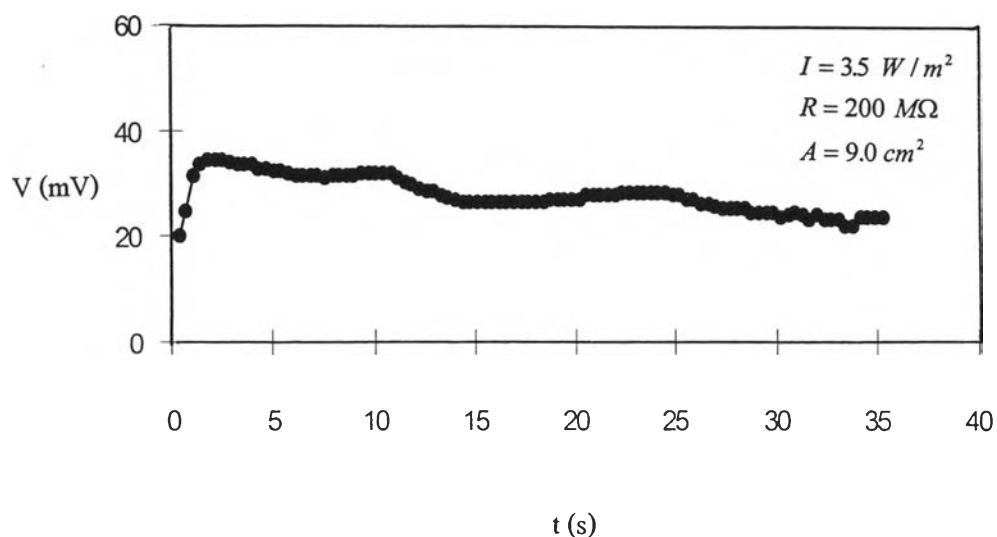
(ข)

รูปที่ 5.10 (ก) และ (ข) แสดงความต่างศักย์ของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นใหญ่ พื้นที่อิเล็กโทรด 9.0 ตารางเซนติเมตร (อิเล็กโทรดด้านหนึ่งทาสีดำ) เมื่อไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากหลอดไฟตกกระทบฟิล์ม โดยมีความต้านทาน 200 เมกะโอห์ม และ 1000 เมกะโอห์มต่อขนานกับฟิล์ม ตามลำดับ



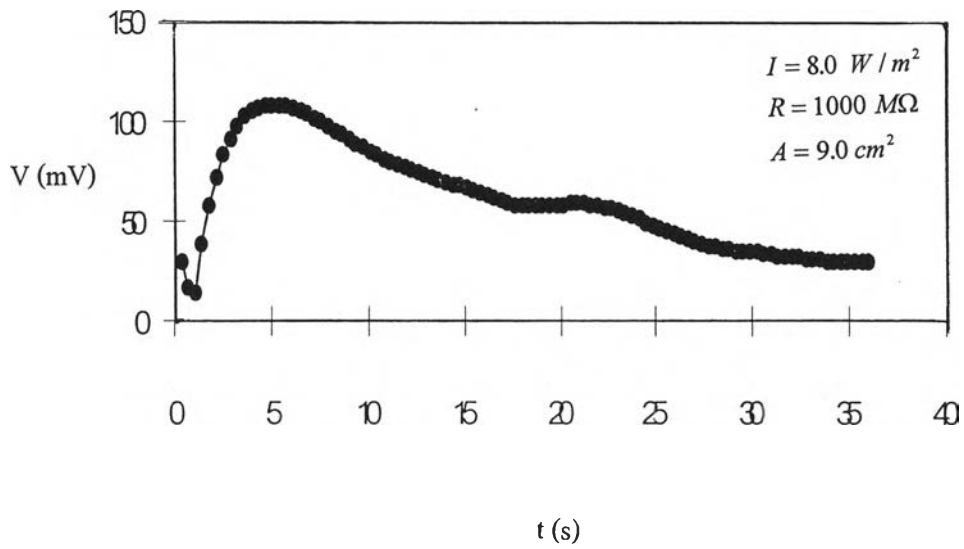


(ก)

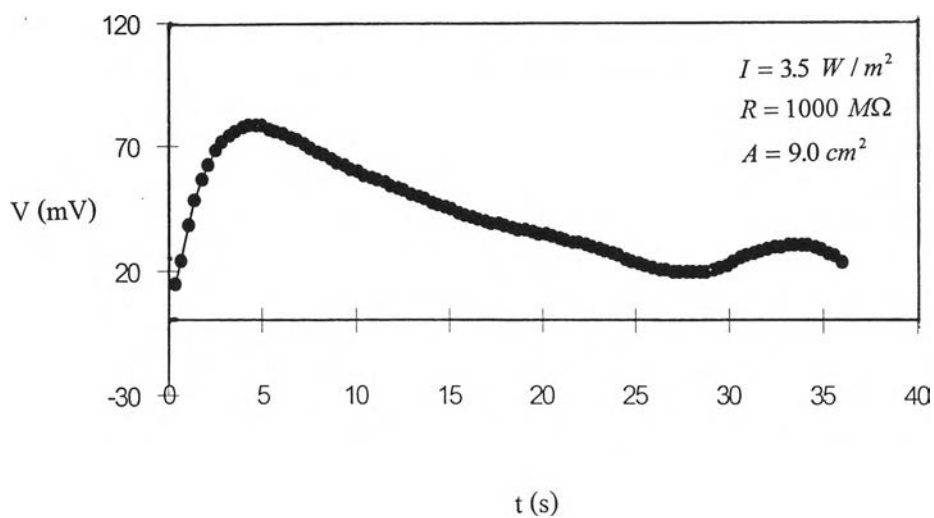


(ข)

รูปที่ 5.11 (ก) และ (ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นใหญ่พื้นที่อิเล็กโทรด 9.0 ตารางเซนติเมตร (อิเล็กโทรดด้านหนึ่งทาสีดำ) ไปด้วยเวลาเมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหลอดไฟความเข้ม 8.0 และ 3.5 วัตต์ต่อตารางเมตร ตกกระทบฟิล์ม โดยมีความต้านทาน 200 เมกะโอห์มต่อขนานกับฟิล์ม



(ก)



(ข)

รูปที่ 5.12 (ก) และ (ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของฟิล์มไพโรอิเล็กทริก PVDF แผ่นใหญ่พื้นที่อิเล็กโทรด 9.0 ตารางเซนติเมตร (อิเล็กโทรดด้านหนึ่งทาสีดำ) ไปด้วยเวลาเมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหลอดไฟความเข้ม 8.0 และ 3.5 วัตต์ต่อตารางเมตร ตกกระทบฟิล์มโดยมีความต้านทาน 1000 เมกะโอห์ม ต่อขนานกับฟิล์ม

ผลการทดลองในรูปที่ 5.10-5.12 สรุปได้ดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 แสดงความต่างศักย์สูงสุด ( $V_{\max}$ ) หน่วยเป็นมิลลิโวลต์ ของฟิล์มแผ่นใหญ่ พื้นที่อิเล็กโทรด 9.0 ตารางเซนติเมตร (อิเล็กโทรดด้านหนึ่งทาสีดำ)

$I (W / m^2)$	$R = 200 M\Omega$	$R = 1000 M\Omega$
0	9.2	43.2
3.5	35.1	80.2
8.0	52.3	109.4

เมื่อเปรียบเทียบตารางที่ 5.2 กับตารางที่ 5.3 จะเห็นได้ว่า สำหรับฟิล์มอันเดียวกันเมื่อทำให้อิเล็กโทรดด้านหนึ่งเป็นสีดำ จะทำให้ความต่างศักย์สูงสุดจากฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาอุปกรณ์ตัวรับรู้ไฟโรอิเล็กทริกให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น หลังจากที่ได้ทราบผลการตอบสนองความต่างศักย์จากฟิล์มไฟโรอิเล็กทริก PVDF เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบฟิล์ม ต่อไปก็จะนำฟิล์มไปประดิษฐ์อุปกรณ์ตัวรับรู้ไฟโรอิเล็กทริก เช่น เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก เครื่องเตือนไฟไหม้ เป็นต้น ดังจะได้กล่าวในบทต่อไป

ดังนั้น ในการนำฟิล์มไฟโรอิเล็กทริก PVDF ไปประยุกต์เป็นตัวจับรังสีอินฟราเรด จะทำให้อิเล็กโทรดด้านหนึ่งเป็นสีดำเพื่อให้สามารถจับรังสีอินฟราเรดได้มากขึ้น